

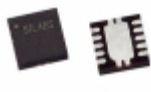




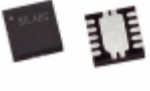
	<h2>SI3460DV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3460DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3460DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24974 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3460DV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24974 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 5.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 1mA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)






SI3460DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3460DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3460DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3460DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3460DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p>	 <p>SI3460DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 7.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3461-E01-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC POWER MANAGEMENT CTRLR 11VQFN</p>	 <p>SI3460DV VISHAY SI3460DV VISHAY</p>
 <p>SI3460DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p>	 <p>SI3460DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p>	 <p>SI3460DV-T1 VISHAY SI3460DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3461-E02-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC POWER MANAGEMENT CTRLR 11VQFN</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458DV-T1-E3	 SI3458DV-T1-E3	 SI3458DV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-E
 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459DV-T1-E3
 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-GE3	 SI3460-E02-GMR	 SI3460-E03-GMR	 SI3460BDV-T1-E3
 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460DDV	 SI3460DDV-T1-GE3
 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DV	 SI3460DV-T1	 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-E3
 SI3460DV-T1-GE3	 SI3461DV-T1-E3	 SI3461DVT1-GE3	 SI3464DV	 SI3464DV-T1-GE3
 SI3464DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-E3	 SI3465DV-T1-E3	 SI3465DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-GE3
 SI3467DV	 SI3467DV-T1-E3	 SI3467DV-T1-E3	 SI3467DV-T1-GE3	 SI3467DV-T1-GE3
 SI3469DV-T1	 SI3469DV-T1-E3	 SI3469DV-T1-E3	 SI3469DV-T1-GE3	 SI3469DV-T1-GE3
 SI3471DV-T1-E3	 SI3473CDV-T1-E3	 SI3473CDV-T1-E3	 SI3473CDV-T1-GE3	 SI3473CDV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited